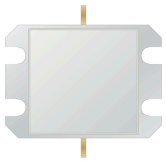
5700–7100 MHz GaN Transistor de puissance à adaptation interne — PSAT 51 dBm (typique)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN Transistor de puissance à adaptation interne.



Valeurs du tableau RF: PSAT 51 dBm (typique); Gain en puissance 11 dB (typique); PAE 45 % (typique). Conditions de mesure RF: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille.

Vg: C = 10 µF

Caractéristiques RF

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Fréquence de fonctionnement	f	5700	-	7100	MHz
Puissance de sortie saturée	-	50.5	51	-	dBm
Gain en puissance	-	10.5	11	-	dB
Rendement en puissance ajoutée	-	40	45	-	%
Planéité du gain en puissance	-	-	-	1.5	dB

Polarisation DC et courants

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Valeur	Unité
Tension de drain en fonctionnement	-	-	-	-	28	V
Tension de grille en fonctionnement	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Valeurs limites

Valeurs limites ; ne constituent pas des consignes de fonctionnement normal.

Paramètre	Symbole	Minimum	Typique	Maximum	Unité
Tension drain-source maximale	-	-	-	32	V
Polarisation de grille minimale	-	-5	-	-	V
Température de stockage	-	-65	-	150	°C
Puissance d’entrée maximale	-	-	-	42	dBm

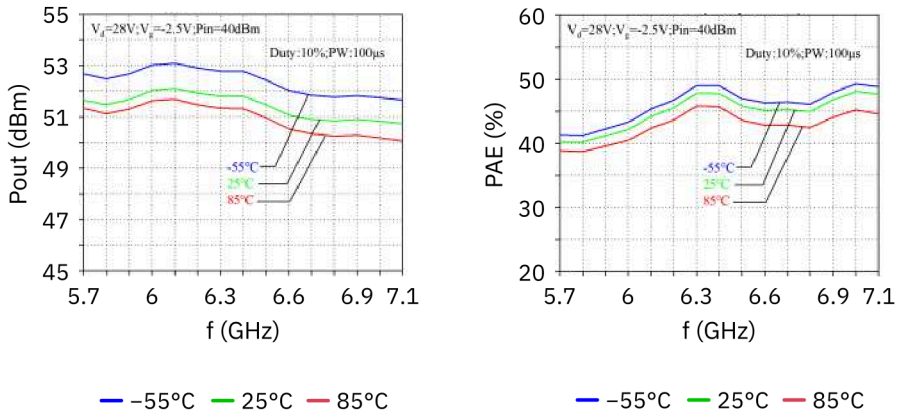
Publication actuelle · 1.5 · 2026-11-12. Mise à jour de la description ou du contenu rédactionnel. Remplace la révision 1.4.

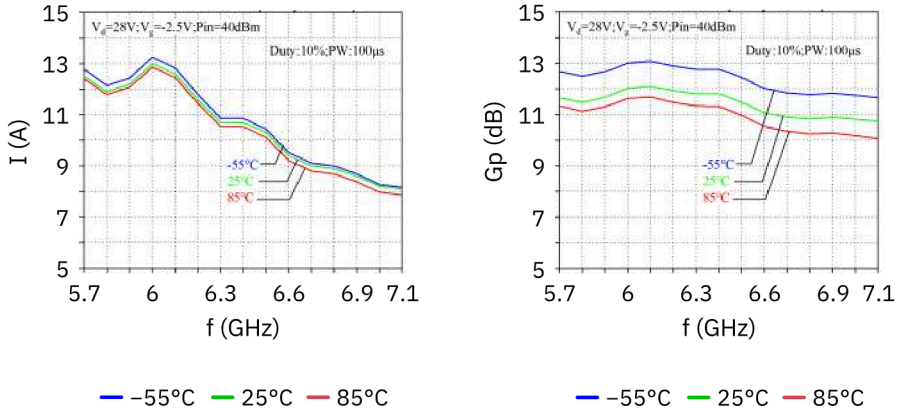
Notes d’intégration

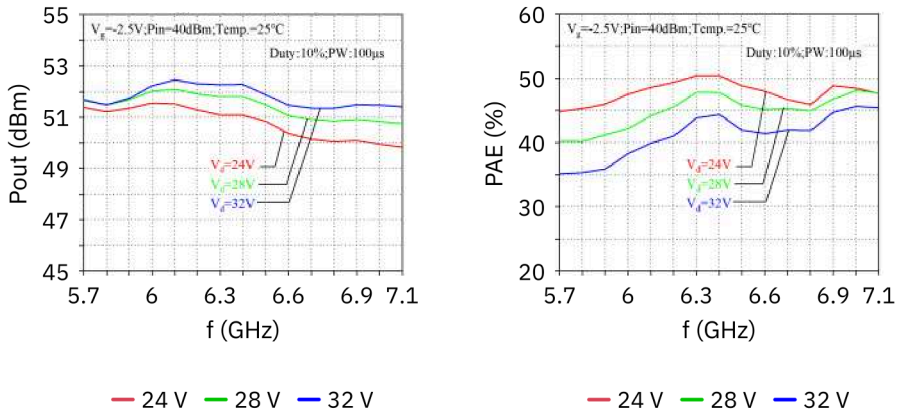
CMW025B Appliquer la polarisation de grille avant celle du drain. Retirer celle du drain avant celle de la grille. Vg: C = 10 µF G: Entrée RF D: Sortie RF S: Source / masse

Courbes de performance

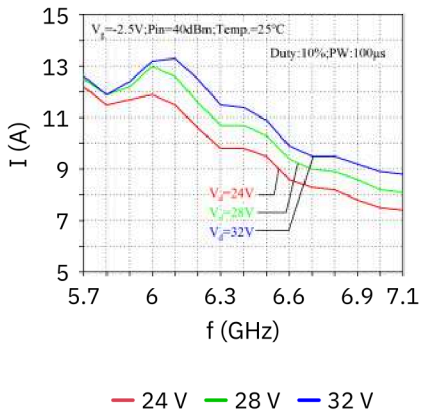
Tenir compte des conditions de fonctionnement indiquées pour chaque figure.

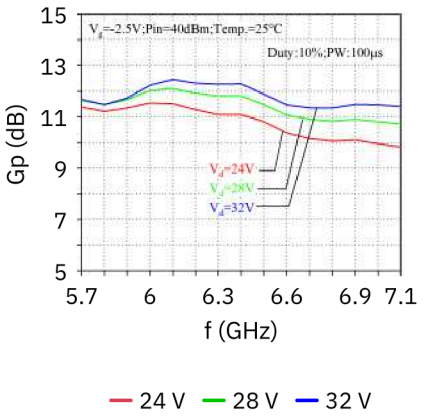






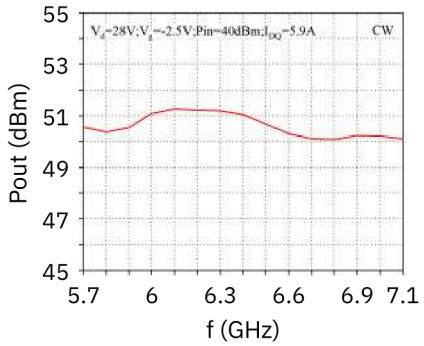
Puissance de sortie; Rendement en puissance ajoutée; Courant de drain; Gain en puissance. Graphiques 1–4: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs; Temp = −55 / +25 / +85°C. Graphiques 5–6: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs.

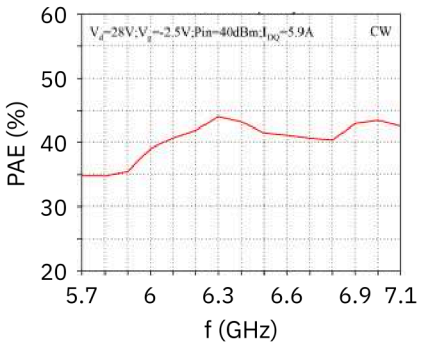


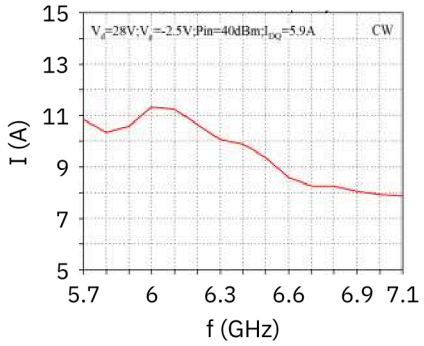


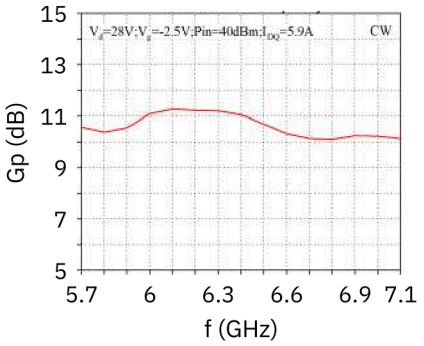
24 V 28 V 32 V

24 V 28 V 32 V

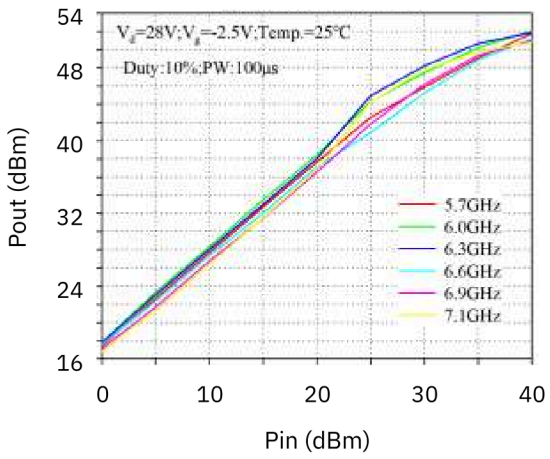


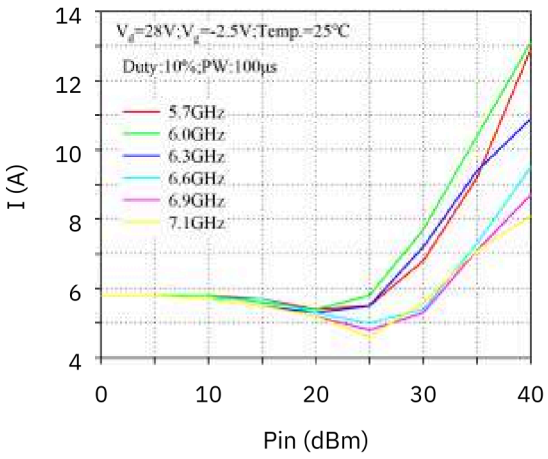






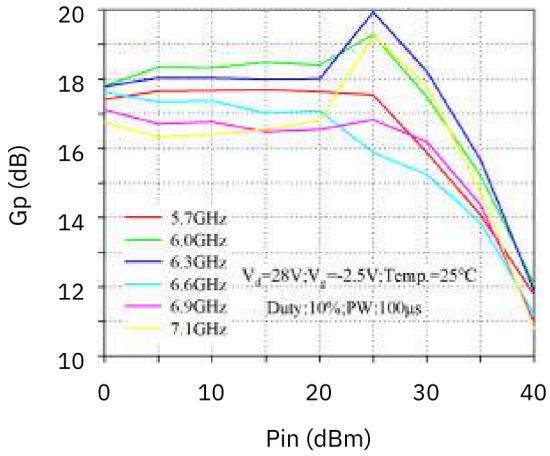
Puissance de sortie; Rendement en puissance ajoutée; Courant de drain; Gain en puissance. Graphiques 1–2: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs. Graphiques 3–6: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

Puissance de sortie; Courant de drain; Gain en puissance. Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

Avis relatif au document

Les spécifications peuvent être révisées. Avant de figer la conception, confirmez auprès de LCRF la révision en vigueur et les exigences propres au produit. L'offre approuvée et les documents de commande définissent la configuration fournie.